

Пленарные доклады

Вторник
4 июля 2006

Актовый зал
Главного корпуса

9:00 – 9:30	Церемония открытия
9:30 – 10:10	Тенденции развития современной кремниевой наноэлектроники Неизвестный И.Г., Асеев А.Л.
10:20 – 10:50	Coffe break
10:50 – 11:30	Солнечная энергетика на основе мультикремния Непомнящих А.И.

11:40 – 14:00

Обед

Секция № 1
Процессы роста из расплава

Актовый зал
Главного корпуса

Председатели: Простомолотов А.И.
Меженный М.В.

14:00 – 14:15	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ МИКРОДЕФЕКТОВ И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ И ПЛАСТИНАХ КРЕМНИЯ Простомолотов А.И., Везуб Н.А., Меженный М.В., Мильвидский М.Г., Резник В.Я.
14:15 – 14:30	ОСОБЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА И ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ ПРИ АСИММЕТРИЧНОЙ ПРЕЦЕССИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ ПО ЧОХРАЛЬСКОМУ Везуб Н.А., Простомолотов А.И.
14:30 – 14:45	ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РОСТА НА МОРФОЛОГИЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ БЗП КРЕМНИЯ. Фрицлер К.Б., Труханов Е.М., Калинин В.В., Смирнов П.Л., Колесников А.В., Василенко А.П.
14: 45 – 15:00	РОСТ МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПО МЕТОДУ СТОКБАРГЕРА-БРИДЖМЕНА А.И.Непомнящих, В.А.Красин, А.Е.Кох, Н.В.Немчинова, С.С.Бельский
15:00 – 15:15	ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РОСТА И ОТЖИГА НА ПАРАМЕТРЫ p -Si (Cz) Ленченко В.М., Шагаров Б.А., Юркина Т.И.
15:15 – 15:30	КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ДЕФЕКТЫ В БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЛАСТИНАХ КРЕМНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ БЫСТРЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТЖИГ. Меженный М.В., Мильвидский М.Г., Резник В.Я.

Секция № 3
Структуры кремний-на-изоляторе

Аудитория
2-03

Председатель: Попов В.П.

14:00 – 14:15	СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИК-НА-ИЗОЛЯТОРЕ - ОСНОВА ПОСТКРЕМНИЕВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В. П. Попов, И. Е. Тыщенко
14:15 – 14:30	СВОЙСТВА СТРУКТУР КНИ С НАНОМЕТРОВЫМИ СЛОЯМИ КРЕМНИЯ О.В.Наумова, Т.А.Гаврилова, Е.В.Вохмина, Н.В.Дудченко, Е.В.Спесивцев, Д.В.Николаев, В.П.Попов
14:30 – 14:45	ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННЫХ СТРУКТУР КРЕМНИЙ-НА-ИЗОЛЯТОРЕ И. Е. Тыщенко, В. П. Попов
14: 45 – 15:00	КНИ-НАНОТРАНЗИСТОРЫ С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЯЕМЫМИ ЗАТВОРАМИ О.В.Наумова, М.А.Ильницкий, Л.Н.Сафронов, В.П.Попов
15:00 – 15:15	СТРУКТУРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ КРЕМНИЯ НА САПФИРЕ, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ СУБЛИМАЦИОННОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ С.А.Денисов, Л.В.Красильникова*, Е.В.Коротков, Д.А.Павлов, С.П.Светлов, Е.А.Питиримова, С.В.Тихов, В.А.Трушин, В.Ю.Чалков, В.Г.Шенгуров
15:15 – 15:30	ВЛИЯНИЕ ТОНКОГО СЛОЯ SiO_2 НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Fe С ПОВЕРХНОСТЬЮ Si(001). В.В. Балашев, В.В. Коробцов, Т.А. Писаренко, А.А. Маткин

Секция № 4
Дефекты и примеси, ионная имплантация, ядерное легирование

Актовый зал
Технологический
Корпус

Председатели: Соболев Н.А.
Борун А.Ф.
Патрин Г.С.

14:00 – 14:15	РЕКОМБИНАЦИЯ ВАКАНСИЙ И МЕЖДОУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ В Si В ПРОТЯЖЕННОЙ ФОРМЕ В ПЛОСКОСТИ {113} Л.И.Федина
14:15 – 14:30	ИНЖЕНЕРИЯ ДЕФЕКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ Н.А.Соболев
14:30 – 14:45	ЯДЕРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Стук А.А., Колин Н.Г.
14:45 – 15:00	ДИНАМИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ КИСЛОРОДА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКОЙ СЛОЕВ КРЕМНИЯ. В.И. Ободников, Е.Г. Тишковский, Л.И. Федина, А.Г. Черков
15:00 – 15:15	ЗАРЯДОВАЯ МОДЕЛЬ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КЛАСТЕРОВ ДЕФЕКТОВ В.М.Ленченко, Ю.Ю.Логинов
15:15 – 15:30	ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ДИСПРОЗИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛА МОНОСИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА Г.С. Патрин, В.В. Белецкий, Н.В. Волков, Д.А. Великанов, О.В. Закиева

15:30 – 16:00

Coffe break

16:00 – 19:00

Постерная сессия. Холл главного корпуса

Пленарные доклады

Среда
5 июля 2006

АКТОВЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА

9:00 – 9:40	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИКРЕМНИЯ. Кузнецов Ф.А., Елютин А.В., Ревенко Ю.А.
9:50 – 10:20	Coffe break
10:20 – 11:00	ИТОГИ ФИЗИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО Бердников В.С.

11:00 – 11:20

Coffe break

Секция № 2
**Эпитаксиальные структуры,
низкоразмерные системы на основе
кремния**

АКТОВЫЙ ЗАЛ
ГЛАВНОГО КОРПУСА

Председатели: Пчеляков О.П.
Саранин А.А.
Асеев А.Л.

11:20 – 11:35	ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКЛАСТЕРОВ In/Si НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ Саранин А.А., Зотов А.В.
11:35 – 11:50	МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВАЯ ЭПИТАКСИЯ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ФОТОВОЛЬТАИКЕ О.П.Пчеляков, А.И.Никифоров, Б.З.Ольшанский, С.А.Тийс, К.Н.Романюк
11:50 – 12:05	КРЕМНИЕВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ А.В.Двуреченский, А.И.Якимов, Н.П.Степина, А.Ф.Зиновьева, А.В.Ненашев, Ж.В.Смагина, В.А.Армбристер В.В.Кириенко, А.К.Гутаковский, В.Г.Кеслер, А.А.Блошкин, Г.Ю.Михалев
12:05 – 12:20	АТОМНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ ПРИ СУБЛИМАЦИИ И АДСОРБЦИИ ЗОЛОТА Косолобов С.С., Родякина Е.Е., Латышев А.В., Асеев А.Л.
12:20 – 12:35	ВЫРАЩИВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР $Ge_xSi_{1-x}/Si(100)$ С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ Ge ($X>0.35$) МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО- ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ Дерябин А.С., Болховитянов Ю.Б., Соколов Л.В., Гутаковский А.К., Колесников А.В.
12:35 – 12:50	ОБРАЗОВАНИЕ И ОТЖИГ ДЕФЕКТОВ В СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ НАНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, Д.В. Марин, В.А. Володин, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, М. Deutschmann*

Секция № 5, 6
Микрокристаллические, аморфные и пористые слои. Новые приборные структуры на основе объемного материала и наноструктур

Технологический
 Корпус

Председатели: Исхаков Р.С.
 Юрченко В.И.

11:20 – 11:35	НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ФАЗА В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ АМОРФНОГО КРЕМНИЯ В.В. Болотов, А.В. Орлов
11:35 – 11:50	ВЛИЯНИЕ NO ₂ НА КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЕВ МЕЗОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ В.В. Болотов, И.В. Пономарева, Ю.А. Стенькин, В.Е. Канн
11:50 – 12:05	СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ МАГНИТНЫЙ МЕТАЛЛ - ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ Р.С. Исхаков, Л.А. Чеканова, В.А. Юзова, С.В. Комогорцев, О.В. Семенова
12:05 – 12:20	СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ Р.С. Исхаков, В.А. Юзова, Л.А. Чеканова, Корец А.Я., С.В. Комогорцев, А.П. Пузырь, О.В. Семенова
12:20 – 12:35	ФЛЭШ ПАМЯТЬ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ВЫСОКОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ В.А. Гриценко, К.А. Насыров, С.С. Шаймеев
12:35 – 12:50	ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Вершинский А. В., Левицкий А. А., Наберухин А. В

Секция № 7
Методы и аппаратура для роста и исследования кремния

Актальный зал
 Президиум КНЦ

Председатели: Владимиров В.М.
 Кобелева С.П.
 Терехин Н.А.
 Шагаров Б.А., Калинин В.В.

11:20 – 11:35	АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ Владимиров В.М., Гринин Э.Ф., Сергей М. Е., Шепов В.Н.
11:35 – 11:50	СВЧ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ННЗ ПО ДИАМЕТРУ И ДЛИНЕ СЛИТКА КРЕМНИЯ. Бородовский П.А., Булдыгин А.Ф., Токарев А.С.
11:50 – 12:05	АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ОБЪЕМНОГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В СЛИТКАХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПО ДАННЫМ СВЧ МЕТОДА С.П. Кобелева, С. Ю. Юрчук
12:05 – 12:20	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ВИК-УЭСА ДЛЯ АНАЛИЗА КАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ. И.М. Анфимов, В.С. Бердников*, К.В. Закутайлов, С.П. Кобелева, Ю.М. Пшеничников*, А.Н. Чиякин.
12:20 – 12:35	СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

	ТОНКИХ ПЛЕНОК И МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ В.А. Швец, С.В. Рыхлицкий, Е.В. Спесивцев, А.Г. Борисов, В.Ю. Прокопьев, С.А. Дулин
12:35 – 12:50	ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ СОСТОЯНИЯ УГЛЕРОДА И БОРА В СИЛЬНОЛЕГИРОВАННЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ SiGe:C(B) В.Д. Ахметов, Х. Рихтер

12:50 – 14:00

Обед

14:00 – 19:00

Экскурсия

Четверг
6 июля 2006

Работа по секциям

Секция № 2
**Эпитаксиальные структуры,
низкоразмерные системы на основе
кремния**

Актовый зал
Главного корпуса

9:30 – 9:45	ВЛИЯНИЕ АТОМОВ БОРА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ НИТРИДИЗАЦИЮ ПОВЕРХНОСТИ Si(111) Маркидонов Е.В., Балашев В.В., Базарсад Х., Коробцов В.В
9:45 – 10:00	ОКИСЛЕНИЕ КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ НА ВОЗДУХЕ Антонова Л.Т., Денисов В.М., Михлин Ю.Л.
10:00 – 10:15	ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МУЛЬТИСЛОЕВ Fe/Si МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ А.С. Паршин, Г.А. Александрова, С.Н. Варнаков, С.А. Куценков, С.Г. Овчинников
10:15 – 10:30	ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ НИТРИДА ГАЛЛИЯ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ И.А. Бобровникова, И.В. Ивонин, В.А. Новиков
10:15 – 10:30	МОДИФИКАЦИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК A_4V_6 НА КРЕМНИИ ПРИ АНОДИРОВАНИИ И ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ Зимин С.П., Богоявленская Е.А., Горлачев Е.С., Бучин Э.Ю., Амиров И.И
10:30 – 10:45	ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК A-Si ИЗ СМЕСИ СИЛАНА С СИЛИЛБОРАНОМ Ф.А. Мукашев, Б.М. Кабланбеков

Секция № 5, 6
**Микрокристаллические, аморфные и
пористые слои. Новые приборные
структуры на основе объемного
материала и наноструктур**

Актовый зал
Технологический
Корпус

9:30 – 9:45	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОДИННЫХ УСТРОЙСТВ КВЧ ДИАПАЗОНА. В.И. Юрченко, С.Д. Воторопин
9:45 – 10:00	ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МДП-СТРУКТУР СО СЛОЯМИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В.А. Викулов, В.В. Коробцов, А.А. Димитриев

10:00 – 10:15	МАГНИТНЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК С НЕМАГНИТНОЙ КРЕМНИЕВОЙ ПРОСЛОЙКОЙ Г.С. Патрин, В.О. Васьковский, Д.А. Великанов, Н.В. Волков, А.В. Свалов, М.А. Щеглова, Е.В. Еремин
10:15 – 10:30	ОПТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КРЕМНИЯ В.И.Юрченко
10:30 – 10:45	МНОГОСЛОЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ТЕРМИЧЕСКИМ ИСПАРЕНИЕМ В СВЕРХВЫСОКОМ ВАКУУМЕ С.Н.Варнаков, J.Bartolome, С.Г.Овчинников, А.С.Паршин, С.В.Комогорцев, Г.В.Бондаренко

Секция № 7

12-этажка

Методы и аппаратура для роста и исследования кремния

9:30 – 9:45	ОПЫТ СОЗДАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ БЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3-ХМЕРНОЙ ГРАФИКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ Абловацкий А.Н., Терехин Н.А., Шагаров В.А
9:45 – 10:00	СИСТЕМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛА КРЕМНИЯ НА РОСТОВОЙ УСТАНОВКЕ «КЕДР» Гордеев В.И., Елисеев Ю.В.
10:00 – 10:15	ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ РОСТОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ ПО МЕТОДУ ЧОХРАЛЬСКОГО Гордеев В.И., Панов П.И.
10:15 – 10:30	РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛЁНОК А.В. Шайдуров, С.Г. Овчинников, Н.Н. Косырев, С.Н. Варнаков
10:30 – 10:45	НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ VEESCO ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ О.И.Киселёва
10:45 – 11:00	ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СРЕДЫ А.Л. Журавлёв, К.В. Лосев, Г.Н. Шелованова

Секция № 8

Аудитория

Солнечный кремний, исходное сырье, очистка, кристаллизация, фэпы

2-03

Председатель: Непомнящих А. И.
Бердников В.С.

9:30 – 9:45	ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВАЯ ПЛАЗМА ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Р.Г. Шарафутдинов, О.И. Семенова, В.Г. Шукин.
9:45 – 10:00	ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАЦИИ И РЕЛАКСАЦИИ ФОТОПРОВОДИМОСТИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Б.А.Красин, А.И.Непомнящих, Ю.С.Мухачев, Р.В.Пресняков, В.Л.Усов, С.М.Рожкова

10:00 – 10:15	МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ БАРБОТАЖА ПРИ РАФИНИРОВАНИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ Бердников В.С., Винокуров В.А., Непомнящих А.И.
10:15 – 10:30	ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ГАЗОФАЗНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРЕМНИЯ РАЗЛОЖЕНИЕМ СИЛАНА И ТРИХЛОРСИЛАНА ПРИ $T > T_{пл}$. В.Н.Демин
10:30 – 10:45	ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ХЛОРИДНЫМ СПОСОБОМ Д.С. Бровин, С.Н. Колгатин, А.А. Ловцюс
10:45 – 11:00	ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИСХОДНОЙ ШИХТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ ДЛЯ ФЭП Т.В.Критская
11:00 – 11:15	АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ СОЛНЕЧНОГО КАЧЕСТВА В СИБИРИ В.И.Юрченко
11:15 – 11:30	ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ «СОЛНЕЧНОГО» СОРТА ИЗ ВЫСОКОЧИСТОГО РАФИНИРОВАННОГО КРЕМНИЯ И.А.Елисеев, А.И.Непомнящих
11:30 – 11:45	НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНТОЩЕНКО В.С., ЛАВРИЩЕВ О.А., МИГУНОВА А.А.

11:30 – 12:00

Coffee break

12:00 – 14:00

Экскурсия по ИФ СО РАН

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 19:00

Постерная сессия. Холл главного корпуса

19:00

Банкет

Вторник 4 июля 2006
16:00 – 19:00

Холл главного корпуса ИФ
Постерная сессия, секции №№ 1, 3, 4

П1.	ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕЦИПИТАТОВ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ Меженный М.В., Мильвидский М.Г., Резник В.Я.
П2.	ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ ПРЕЦИПИТАТОВ В КРЕМНИИ Логинов Ю.Ю.
П3.	УРАВНЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ И НАКОПЛЕНИЯ ВАКАНСИЙ В КРИСТАЛЛЕ, ВЫРАЩИВАЕМОМ ИЗ РАСПЛАВА Ленченко В.М.
П4.	РАСЧЕТЫ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ РОСТА НА КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ МЕЖДУ РАСПЛАВОМ И РАСТУЩИМ КРИСТАЛЛОМ Ленченко В.М.
П5.	ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА НА ФОРМУ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО. Бердников В.С., Винокуров В.А., Винокуров В.В., Гапонов В.А.
П6.	КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО В РЕЖИМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ КРИСТАЛЛА И ТИГЛЯ. Бердников В.С., Винокуров В.А., Гапонов В.А.
П7.	ВЛИЯНИЕ КОНВЕКЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРИ БЗП НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ Червонный И.Ф., Егоров С.Г., Воляр Р.Н.
П8.	ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПРИМЕСНОГО СОСТАВА НА ВЕЛИЧИНУ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ Н.Н.З. В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ Червонный И.Ф., Воляр Р.Н., Егоров С.Г.
П9.	НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПРИБОРНЫХ СЛОЕВ СТРУКТУР «КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ» ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ А.В. Скупов, В. Д. Скупов
П10.	ДИСЛОКАЦИОННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В Si:Er ДИОДАХ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ И ФОСФОРОМ Н.А. Соболев, А.М. Емельянов, В.В. Забродский, Н.В. Забродская, В.Л. Суханов
П11.	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЩНЫХ ТИРИСТОРОВ Стук А.А., Свистельникова Т.П., Локтаев Ю.М.*, Сурма А.М.*, Черников А.А.**
П12.	НАПРЯЖЕНИЯ В РЕШЕТКЕ Si ВБЛИЗИ ПРЕЦИПИТАТОВ β - FeSi_2 А.Ф. Борун, Е.А. Выговская, Ю.Н. Пархоменко, Е.Г. Полякова, О.В.Торопова
П13.	ЛЕГИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ. Н.В. Латухина, В.М. Лебедев*
П14.	ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ МЕТАЛЛОВ IIA И IVA ГРУПП В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ Прокофьева В.К., Рыгалин Б.Н., Соколов Е.Б.
П15.	ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЦИИ УДАРНЫХ ВОЛН КАСКАДАМИ АТОМНЫХ СМЕЩЕНИЙ ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ А.В. Скупов, В.Д. Скупов
П16.	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ p- и n-

	ОБЛАСТЕЙ В ОБЛУЧЕННОМ КРЕМНИИ. Смагулова С.А., Антонова И.В., Неустроев Е.П.
П17	ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ ПО МЕТОДАМ ЧОХРАЛЬСКОГО И БРИДЖМЕНА Калаев В.В., Кулиев А.Т., Дурнев Н.В., Макаров Ю.Н.

Четверг 6 июля 2006
15:00 – 19:00

Постерная сессия, секции №№ 2,5,6,7,8

П1.	СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ GESI, ВЫРАЩЕННЫХ НА ВИЦИНАЛЬНЫХ ПОДЛОЖКАХ Si (001) А.В. Колесников, А.Ю. Красотин, Е.М. Труханов, А.П. Василенко, А.С. Дерябин, А.С. Ильин.
П2.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА КРЕМНИИ Н.И.Плюснин, В.М.Ильященко, С.А.Китань, С.В.Крылов
П3.	ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПОЛЮСНЫХ ФИГУР ДЛЯ ОПИСАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК НА КРЕМНИИ Зимин С.П., Богоявленская Е.А., Наумов В.В.
П5.	ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА СВЧ МЕТОДОМ. С.П.Кобелева, С. Ю.Юрчук
П6.	ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ВИК-УЭСА ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ И. М. Анфимов, В. С. Бердников**, М. В. Герасимов, К. Л. Енишерлова*, С. П. Кобелева, Э. М. Темпер*, Т. С. Цаллагова*
П7.	АНАЛИЗ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ СТРУКТУР Si-sio ₂ , ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ Si и Ge (МОДЕЛИРОВАНИЕ). В.А. Швец, В.Ю. Прокопьев, С.И. Чикичев
П8.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В ТОНКИХ ПЛАСТИНАХ ЧОХРАЛЬСКОГО КРЕМНИЯ МЕТОДОМ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ В.Д. Ахметов, Х. Рихтер
П9.	ДИАГНОСТИКА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 1200 ⁰ М.С. Журавель, Петлицкий А.Н., В.И.Плебанович, О.В.Турутина
П10.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ТЕРМИЧЕСКИ ВЫРАЩЕННЫХ ПЛЕНОК ОКСИДА КРЕМНИЯ ОТ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН Ю.Б.Васильев, В.И.Плебанович, И.В.Простов, А.В.Турыгин
П11.	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР А.А. Величко, А.А. Корнилович, Е.И. Уваров, С.П. Хабаров
П12.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ИЗГИБА И КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ А.С. Ильин, А.П. Василенко, Е.М. Труханов, А.А. Федоров, А.В. Колесников
П13.	ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ В.В.Калинин, А.М.Мясников
П14.	МЕТОДИКИ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Егоров Н. М., Казанцев А. В., Казанцев В. В., Левицкий А. А.
П15.	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯМИ В УСТАНОВКЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ. Н.Н. Косырев, С.Н. Варнаков, С.Г. Овчинников, А.Е. Худяков
П16.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ФАЗ КРЕМНИЙ-АДСОРБАТ НА КРЕМНИИ Цуканов Д.А., Рыжков С.В., Лавринайтис М.В.
П17.	ЭКСПРЕСС МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОРИСТОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СРЕД А.Л. Журавлёв, К. В. Лосев, В.В. Симченко, Г. Н. Шелованова
П18.	ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Р.Г. Шарафутдинов, В.Г. Шукин, Е.А. Баранов, М.В. Пономарев, В.О. Константинов, О.И. Семенова*
П19.	ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМЫ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЛОСКОДОННОМ ВАРИАНТЕ МЕТОДА БРИДЖМЕНА. Бердников В.С., Григорьева А.М., Кудрявцева М.А., Филиппова М.В.
П20.	ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ-ПРИМЕСЕЙ В КРЕМНИЙ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЙ КАРБОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ Немчинова Н.В.*, Клёц В.Э.*, Бельский С.С.*, Бычинский В.А.**
П21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА КРЕМНИИ Н.И. Плюсин, В.М.Ильященко, С.А.Китань, С.В.Крылов
	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЯ И ФЭП А.В.Юрченко, В.И.Юрченко